

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности  
**главного научного сотрудника – заведующего лабораторией**  
в лаборатории полупроводниковой квантовой электроники

**Вакансия VAC\_26686**

**Тематика исследований**

Исследования и разработки в области физики и технологии полупроводниковых и металлических наноструктур, исследование оптических, электрических, магнитных и химических (каталитических) свойств таких структур, разработка новых оптоэлектронных приборов, сенсоров, источников тока, катализаторов.

**Трудовая деятельность**

Осуществление научного руководства конкретными темами исследований согласно государственному заданию и планам НИР по утверждённым целевым программам, а также подготовка и подача заявок на новые проекты в рамках базового бюджетного и целевого финансирования; руководство работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечение выполнения ими правил внутреннего распорядка в учреждении. Непосредственное участие в выполнении исследований: разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координация деятельности соисполнителей работ; обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения. Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области (руководство дипломными и курсовыми работами).

**Особенности трудовой деятельности:** главный научный сотрудник – заведующий лабораторией полупроводниковой квантовой электроники несет полную материальную ответственность за имущество, закрепленное за лабораторией, а также работает со сведениями, составляющими государственную тайну по ф. 3.

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории полупроводниковой квантовой электроники на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов.

- Наличие ученой степени доктора физ.-мат наук.
- Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений: не менее 200
- Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности: не менее 15
- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования: Scopus (шт.): не менее 100, Web of Science (шт.): не менее 140, РИНЦ (шт.): не менее 180
- Индекс Хирша: не менее 10.
- Опыт научной работы: не менее 10 лет.
- Опыт научно-организаторской работы: не менее 10 лет.

За последние 5 лет руководство не менее чем 3 проектами в рамках ФЦП Минобрнауки, Минпромторг и др.; не менее чем 2 договорами НИОКР с научно-производственными организациями-заказчиками; не менее 3 грантами отечественных и зарубежных научных фондов.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).